

الباب الثالث عشر

الخواص المغناطيسية للجوامد

ترتبط الخواص المغناطيسية للمواد بالحركة المدارية والمغزلية للالكترونات في ذراتها . وتقاس عادة هذه الخاصة المغناطيسية بالقابلية المغناطيسية magnetic susceptibility لوحدة الحجم من المادة X وتعريفها هو :

$$X = M / H$$

حيث M هو العزم المغناطيسى لوحدة الحجم «magnetization»

و H هو الشدة المغناطيسية .

المواد أنواع :

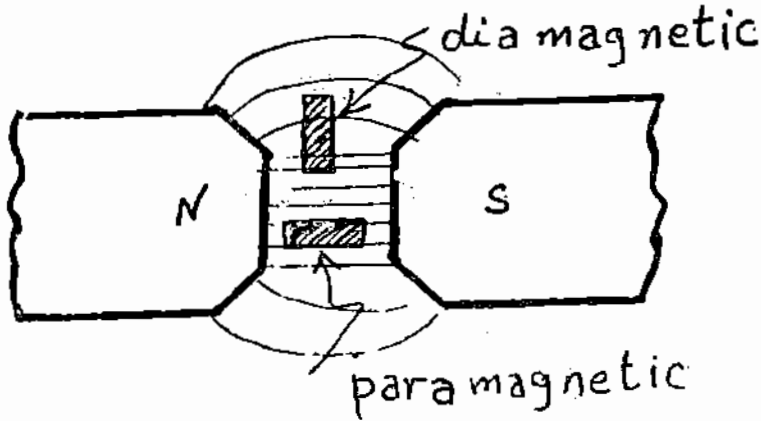
(أ) مواد ديا مغناطيسية : Dia magnetic

ويكون لها قابلية مغناطيسية سالبة أى أنها تتنافر مع الأجزاء القوية من المجال المغناطيسى اذا وضعت فيه

(ب) مواد بارا مغناطيسية : Para magnetic

وهى التى تنجذب للمناطق القوية فى المجال المغناطيسى . وقابليتها موجبة .

وإذا كانت القابلية المغناطيسية لهذه المواد كبيرة جدا سميت بالمواد
الفرو مغناطيسية Ferro - magnetic



شكل (١٣ - ١)

إذا وضعنا مادة ما في مجال مغناطيسي فإنها تنجذب أو تتنافر معه
بقوة F تتناسب مع شدة المجال H وكذلك مع معدل تغير المجال مع
المسافة $\frac{dH}{dx}$ أي أن

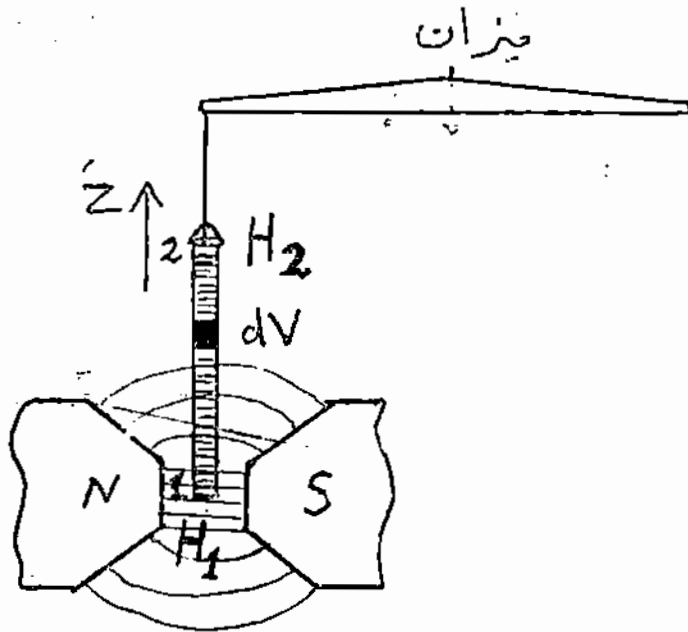
$$F = X \cdot V \cdot H \cdot \frac{dH}{dx}$$

حيث V هو حجم المادة وتعطى القابلية المغناطيسية X مقياسا
للتغير في العزم المغناطيسي للذرات بعد التاثير بالمجال H

قياس القابلية المغناطيسية :

طريقة جوى Gouy method

توضع المادة على شكل اسطوانة رفيعة بين طرفي مغناطيس قوى يكون
المجال فيه غير منتظم . وتقاس القوة المؤثرة على المادة (سواء كانت جاذبة



شكل (١٣ - ٢)

كما في حالات المواد البارامغناطيسية او نافرة كما في حالات المواد انديا مغناطيسية) بواسطة ميزان حساس .

القوة في الاتجاه الراسي والمؤثرة على حجم صغير dV هي

$$dF_z = \chi H \frac{dH}{dz} \cdot dV$$

$$= \frac{1}{2} \chi \frac{dH^2}{dz} dx dy dz$$

$$\therefore dF_z = \frac{1}{2} \chi \frac{dH^2}{dz} dx dy dz$$

وتكون القوة الكلية المؤثرة على الجسم هي :

$$F_z = \frac{1}{2} \times \int_1^2 \frac{d}{dz} H^2 dx dy dz$$

$$= \frac{1}{2} \times A (H_1^2 - H_2^2)$$

حيث A هي مساحة مقطع المادة $(dx dy)$ و H_1 ، H_2 هما شدتي المجال عند طرفي المادة . ولما كانت H_1 أكبر جدا من H_2 وذلك في حالة مادة أسطوانية طويلة طرفها العلوي بعيد عن قطبي المغناطيس ، ولما كانت قيمة المجال مربعة في القانون لذلك يمكن إهمال H_2^2 بالنسبة إلى H_1^2 وتصبح القوة على المادة

$$F_z = \frac{1}{2} \times A H^2$$

حيث H هي شدة المجال بين قطبي المغناطيس ويمكن قياسها عمليا بواسطة فلكسومتر وملف بادث

وقد وجد أن القابلية المغناطيسية لمعظم المواد سواء البارا أو الדיا مغناطيسية صغيرة وتتراوح قيمتها بين ١٠ . ١ و ١٠ . ٧

نظرية لانجفين للديا مغناطيسية

Langevin Diamagnetism equation,

يؤثر أي مجال مغناطيسي على حركة الكروونات الذرة فيعطيها حركة رحيوية ω_L إضافية لها تردد زاوي angular frequency

$$\omega_L = \frac{eH}{2mc}$$

تعادل الحركة الرحوية للتوزيع الالكتروني
The precession of the electron distribution

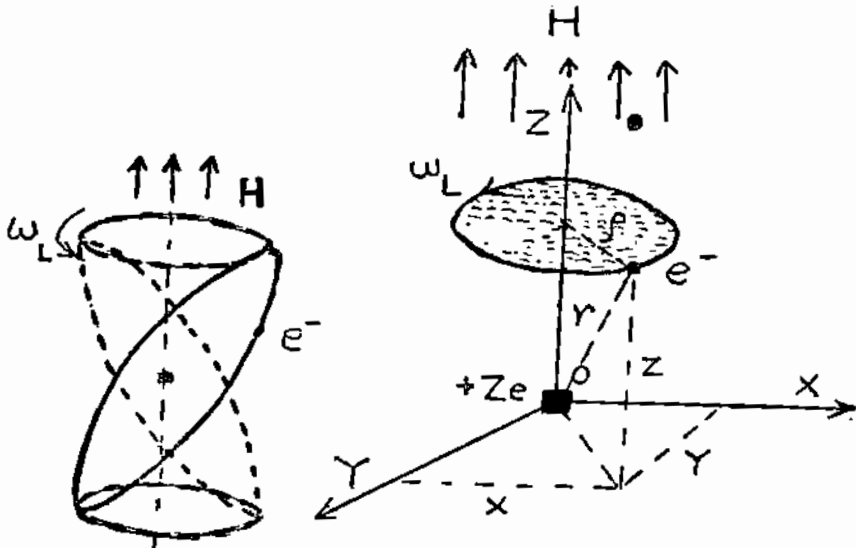
تيارا ديا مغناطيسيا I يفتى بالمعادلة :-

$$I = - \frac{Z e}{C.T.} = - \frac{Z e \omega L}{2 \pi C} \quad \text{m.u.}$$

$$\therefore I = - \frac{Z e}{2 \pi c} \cdot \frac{e H}{2 m c} \quad \text{e.m.u.}$$

العزم المغناطيسي M هو حاصل ضرب التيار في مساحة المسار
نإذا كان ρ هو متوسط نصف قطر الحركة الرحوية للالكترون حول
المجال المغناطيسي يكون

$$M = - \frac{Z e^2 H}{4 \pi m c^2} \times \pi \rho^2$$



شكل (١٣ - ٣)

إذا كانت \bar{r} هي متوسط نصف قطر مسار الإلكترونات وباعتبار
 توزيعاً كروياً للشحنة حول النواة ، يكون $x^2 = y^2 = z^2$
 ويكون $x^2 + y^2 + z^2 = r^2 = \frac{3}{2} \rho^2$

ويصبح العزم المغناطيسي للذرة الواحدة هو :

$$M = - \frac{Z e^2}{6m c^2} H \bar{r}^2$$

فإذا كان هناك عدد N ذرات في وحدة الحجم من المادة تكون
 القابلية المغناطيسية لوحدة الحجم هي :

$$X = \frac{M}{H} = - \frac{Z e^2}{6m c^2} N \bar{r}^2$$

ويمكن تعيين قيمة \bar{r}^2 إذا عرف توزيع الشحنات حول النواة ويتم
 حساب ذلك باستخدام ميكانيكا الكم . والحل الوحيد الكامل لهذه المشكلة
 هو ذرة الأيدروجين . ولكن توجد حلول تقريبية للأنواع الأخرى من الذرات
 تعطى قيماً للقابلية المغناطيسية X بحيث تتفق النظرية مع التجربة .

النظرية الكمية للبارا مغناطيسية Quantum theory of paramagnetism

تكون الذرة بارا مغناطيسية إذا كان لها محصلة عزم مغناطيسي ناشئ
 عن تحصيل العزم المغناطيسي المدارى والمغزلى .

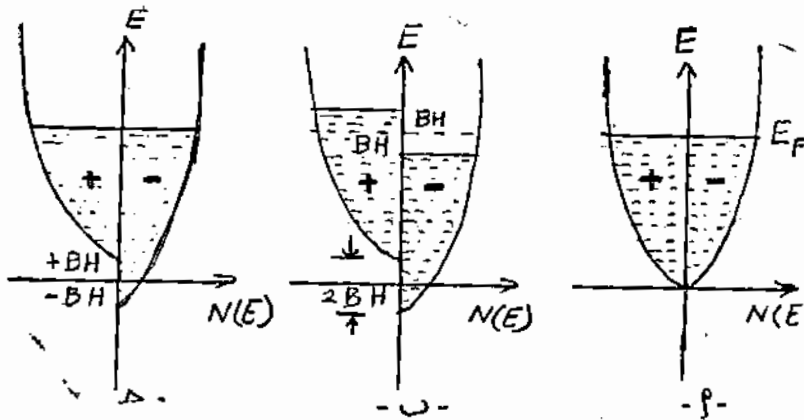
جميع الذرات التى تحتوى عددا فرديا من الإلكترونات تكون بارا
 مغناطيسية حيث أن العزم المغناطيسى المغزلى لا يمكن أن يكون صفرا .

عند التأثير بمجال مغناطيسى خارجى فان العزوم المغناطيسية المغزلية
 تترتب اما موازية او عكس موازية لاتجاه المجال المغناطيسى تبعا

• لاتجاه الحركة المغزلية للالكترون (parallel or anti-parallel)

تتوقف الخواص البارامغناطيسية للبلورات على ترتيب الحركة التعاونية للعزوم المغناطيسية الالكترونية في اتجاه او في عكس اتجاه المجال .

عند تطبيق احصاء فيرمي وديراك على الغاز الالكتروني في الفلز نجد ان توزيع الالكترونات عند درجة الصفر المطلق يكون على شكل دالة قطع مكافئ وتمثل العلاقة بين كافة مستويات الطاقة $N(E)$ بدلالة الطاقة E (انظر شكل ١٣ - ٢)



شكل (١٣ - ٤)

عند الصفر المطلق وفي غياب اي مجال مغناطيسي تكون جميع المستويات الاقل من طاقة فيرمي E_F مشغولة بالالكترونين لكل مستوى

• يكون مغزلاهما متعاكسين $S = \pm \frac{1}{2}$

اي ان الالكترونات تشكل مجموعتين تبعا للحركة المغزلية . وعند التأثير بمجال مغناطيسي نجد ان الالكترونات ذات المغزل الموجب مثلا تترتب في اتجاه المجال بينما تترتب عكس ذلك الالكترونات الاخرى .

إذا كان بوهر ماجنتون هو B وشدة المجال H نجد ان طاقة كل الكترون مغزلة موجب تزداد بمقدار BH + بينما تنقص طاقة الألكترون ذو المغزل السالب بمقدار BH - ونحصل على الشكل ب . وهذا الوضع غير مستقر . وتتساوى في الحال مستويات الطاقة العليا تحت تأثير التهييج الحرارى

فمثلا : إذا كان $H = 10^5$ Oe يكون المقدار $BH = 10^{-3}$ eV ولهذا السبب فان kT تكون أكبر كثيرا في المعتاد من BH ولهذا السبب نجد أن القابلية المغناطيسية لبعض الفلزات لا تتأثر بدرجة الحرارة وهو خلاف ما ينص عليه قانون كورى الذى يعطى تغيرا عكسيا لـ X مع T

تغير القابلية المغناطيسية مع درجة الحرارة :

اعتبر البارا مغناطيسية الناشئة عن الحركة المغزلية للإلكترونات

$$ms = \pm \frac{1}{2}$$

عند التأثير بمجال مغناطيسى H تنفلق مستويات الطاقة بمقدار

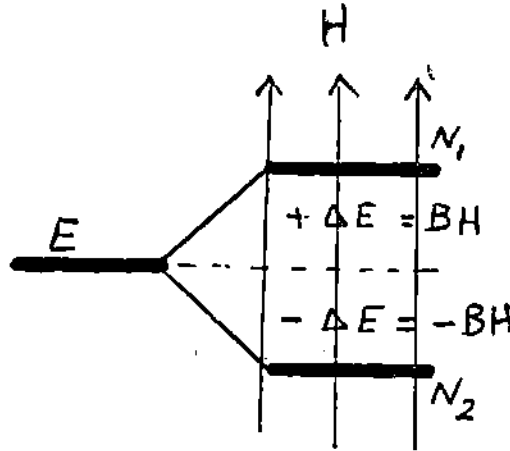
$$\Delta E = g B H ms$$

حيث g هو ثابت الانشطار للاندى Landé splitting factor ،
 ms هو العدد الكمى المغناطيسى المغزلى .

نفرض أن هناك مستوى واحد فقط انفلق الى مستويين في وجود المجال المغناطيسى وأن تعداد الإلكترونات ذات المغزل الموجب على المستوى الأول هو N_1 بينما تعداد الإلكترونات ذات المغزل السالب على المستوى الآخر هو N_2 . إذا كان N هو العدد الكلى للذرات لوحدة الحجم يكون

$$N = N_1 + N_2$$

باستخدام احصاء ماكسويل وبولتزمان يكون تعداد الإلكترونات على



شكل (١٣ - ٥)

المستوى الأول عند الاتزان الديناميكي الحراري عند الدرجة $T^\circ K$ هو

$$N_1 = e^{\Delta E/kT}$$

وتعداد الألكترونات على المستوى الثاني

$$N_2 = e^{-\Delta E/kT}$$

بقسمة المعادلتين :

$$\therefore \frac{N_1}{N} = \frac{e^{\Delta E/kT}}{e^{\Delta E/kT} + e^{-\Delta E/kT}}$$

أيضا

$$\frac{N_2}{N} = \frac{e^{-\Delta E/kT}}{e^{\Delta E/kT} + e^{-\Delta E/kT}}$$

ويكون بذلك مقدار المغناطيسية الناشئة عن N ذرات في وحدة الحجم هو :

$$M = g B m_s (N_1 - N_2)$$

$$= g B N m_s \frac{e^{-x} - e^{+x}}{e^{-x} + e^{+x}} = m_s B N g \tanh x$$

$$\frac{\Delta E}{kT} = x = g B m_s H / kT \quad \text{حيث}$$

عند ما تكون $\tanh X = X \therefore X \ll 1$

$$\therefore M = m_s B N g \cdot \frac{g B m_s H}{k T} = \frac{N g^2 m_s^2 B^2 H}{k T}$$

معامل الانشطار للاندى للالكترونات $g = 2$ يساوى اثنين وبوضع $m_s = \frac{1}{2}$ نحصل على القابلية المغناطيسية X

$$X = \frac{M}{H} = \frac{N B^2}{k T}$$

أي أن X تتناسب عكسيا مع درجة الحرارة المطلقة T

الرنين الإلكتروني البارامغناطيسي
Electron paramagnetic resonance E S R

عند وضع بلورة يارا مغناطيسية في مجال مغناطيسي H في اتجاه Z تنتفق مستويات الطاقة الإلكترونية تبعا لتأثير زيمان .

التغير في طاقة الألكترون ΔE هو

$$\Delta E = g B H m_s$$

الفارق بين مستويي الطاقة الذين استحدثنا بواسطة التأثير بالمجال المغناطيسى هو

$$\Delta E = 2 g B H m_s$$

حيث B هو ماجنتون بوهر ، معامل الانشطار للاندى بالنسبة
للإلكترونات يساوى 2 ، $m_s = \frac{1}{2}$.

$$\Delta E = 2 B H \quad \text{أى أن}$$

عند ما تؤثر على المادة بمجال كهربي متردد تردده ν يمكن احداث انتقال للإلكترونات من المستوى الأول للثانى وبالعكس .

الطاقة التى يمتصها الألكترون للانتقال للمستوى الأعلى هى

$$E = h \nu = 2 B H$$

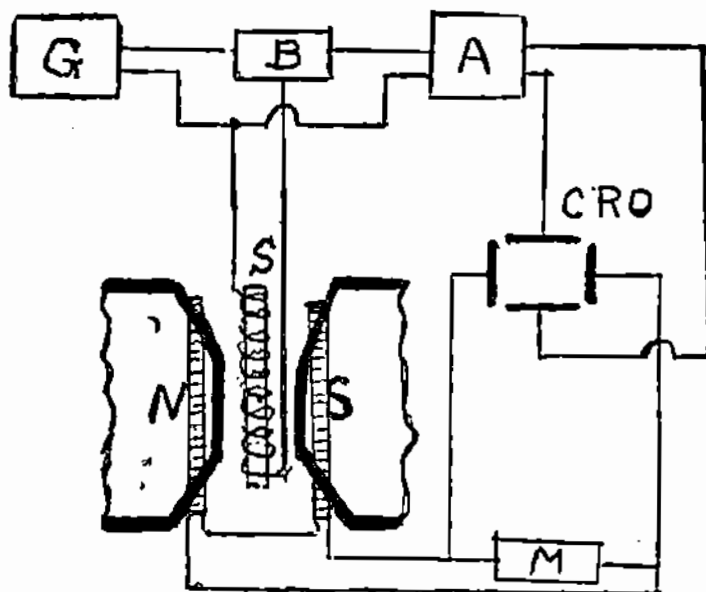
عند ما يتساوى $h\nu$ بالمقدار $2 B H$ يحدث رنين الكترونى مغزلى
لأن انتقال الألكترون من المستوى الأقل طاقة للأعلى يتحتم معه أن يغير
الإلكترون من اتجاه حركته المغزلية وبالمثل عند ما يعود للمستوى الأصلى .

ولذلك تسمى هذه العملية $E S R$ electron spin resonance
الرنين الألكترونى المغزلى .

ويوجد عادة طريقتين لاحداث الرنين الأولى هى بتغيير شدة
المجال المغناطيسى H مع تثبيت التردد للمجال الكهريائى والأخرى
بالعكس تثبت المجال H ونغير التردد للمجال الكهريائى .

عند حدوث الرنين تمتص طاقة الرنين من دائرة المجال الكهريائى

ويؤخذ لذلك التردد الذي يحدث عنده أكبر امتصاص للطاقة على أنه
 تردد الرنين .



طريقة الرنين الإلكتروني المغزلي
 (E S R)

شكل (١٣ - ٦)

G = r.f. signal generator

S = sample mounted in a coil.

H_z r.f. magnetic field, B bridge

A r.f. amplifier, CRO oscilloscope.

H_z is constant static magnetic field slowly modulated by modulator M

Nuclear magnetic resonance. NMR الرنين المغناطيسي النووي

يوجد لنواة الذرة أيضا كمية حركة زاوية مصاحب لها عزم مغناطيسي يتأثر هو الآخر بالمجال المغناطيسي الخارجى ويحدث انفلاق في مستويات الطاقة داخل النواة . يحدث رنين نووى مغناطيسى عند ما تتذبذب النواة بين مستويات الطاقة

Cyclotron resonance رنين السيكلوترون

عند وضع بلورة شبه موصلة في مجال مغناطيسى مستقر تتحرك الالكترونات داخلها في مسارات حلزونية حول اتجاه المجال . اذا كان نصف قطر المسار هو r وسرعة الالكترون v تكون القوة الطاردة هي :

$$F = \frac{m^* v^2}{r}$$

وهذه القوة تتزن مع قوة لورنتز على الالكترون والناشئة عن المجال H

$$F = \frac{H e v}{c}$$

$$\therefore \frac{m^* v^2}{r} = \frac{H e v}{c}$$

عند التأثير بمجال متردد اتجاهه عمودى على اتجاه المجال المستمر ω يحدث رنين بين تردد المجال المتغير $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ وتردد الحركة الالكترونية في المجال المستمر عند ما يتساوى الترددان .

بقياس الامتصاص لطاقة المجال المتردد نحصل على أكبر امتصاص maximum absorption عند حدوث الرنين وبذلك يمكن تعيين تردد الالكترون في المجال المستمر .

من المعادلة السابقة

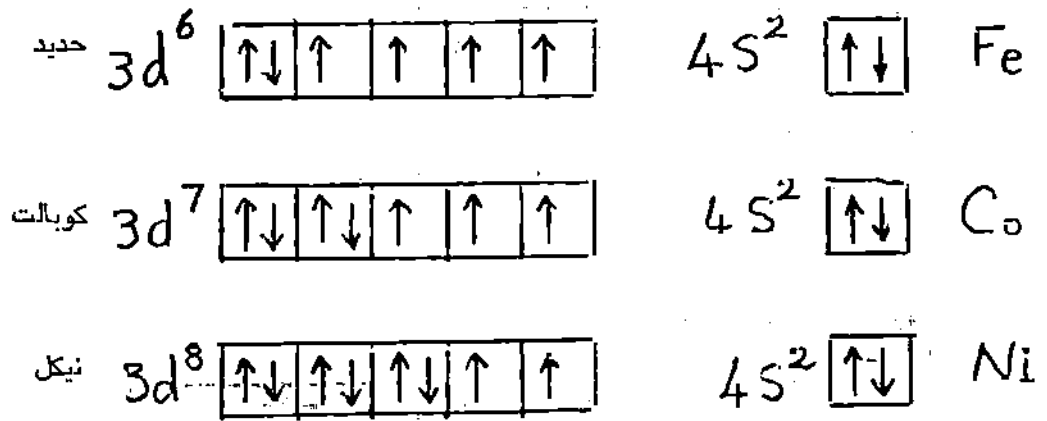
$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{e H}{m^* c}$$

حيث m^* هي الكتلة الفعالة للالكترون في البلورة . ونظرا لأن هذه التجربة تشبه عادة ما يحدث داخل السيكلوترون لذلك فتسمى الظاهرة برنين السيكلوترون وأهميتها في أنها تسمح بتعيين قيمة m^*

الخاصة الفيرو مغناطيسية Ferro-magnetism

ينطبق التحليل السابق لمغناطيسية المواد على تلك البلورات التي يكون فيها الأغلفة الداخلية inner shells ممتلئة تماما بالالكترونات وتكون الكترونات التكافؤ valence electrons حرة الحركة في البلورة . وينشأ العزم المغناطيسي للذرة في هذه الحالة من الحركة المغزلية لهذه الالكترونات .

أما في بعض الفلزات فيوجد داخلها أغلفة غير ممتلئة تماما بالالكترونات وفي هذه الحالة تساهم الحركة المدارية بالإضافة الى الحركة المغزلية للالكترونات في تكوين العزم المغناطيسي لذرات هذه المواد . ويؤدي ذلك الى قيم مرتفعة جدا للقابلية المغناطيسية . ويطلق على مثل هذه المواد بالفيرو مغناطيسية مثل الحديد والكوبالت والنيكل .



شكل (١٣ - ٧)

تتوزع الإلكترونات الفلزات السابقة دخل الغلاف على $d - shell$ مستويات الطاقة كما مبين بشكل (١٣ - ٧)

أى أن العزم المغناطيسى الذرى لهذه الفلزات (حديد - كوبالت - نيكل) على الترتيب تساوى أربعة ثلاثة ، اثنين بوهر ماجنتون .

Ferro-magnetic domains

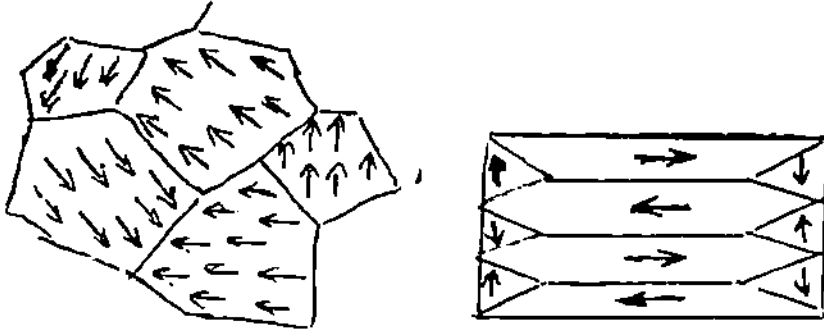
الناطق الفيرو مغناطيسية

في المواد الفيرو مغناطيسية يكون تأثير المجال المغناطيسى على الحركة المغزلية للإلكترونات قويا مما يسبب أن تتراص هذه الحركات بجوار بعضها محاولة أن تأخذ لتجاة المجال المغناطيسى .

حتى في حالة عدم وجود مجال خارجى فان المجالات الجزئية لهذه المغناطيسيات الجزئية قد تسبب تراض هذه الحركات المغزلية في مناطق متجاورة قد تختلف بينها اتجاهات التراض . وتسمى بالمناطق المغناطيسية ولا يوجد صلة بين هذه المناطق domains وحببيات المادة متعددة الحبيبات poly crystalline اذ ان الحبيبة grain الواحدة قد تحتوى على العديد من المناطق المغناطيسية .

وعند ايجاد محصلة العزم المغناطيسى لكل هذه المناطق نجد أن العزم يساوى صفرا اذا كانت المادة غير ممغنطة .

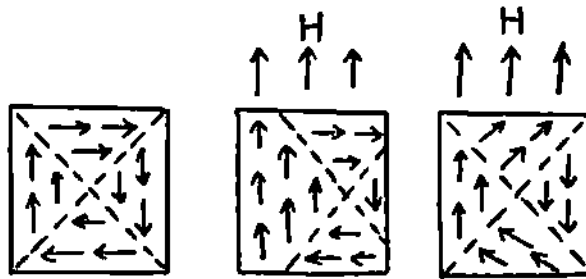
يبين الشكل مادة فيرو مغناطيسية غير ممغنطة العزم الكلى المغناطيسى فيها يساوى صفرا . تبين الأسهم اتجاه المغنطة داخل المناطق المختلفة .



شكل (١٣ - ٨)

كيفية تمغنط المواد الفيرو مغناطيسية : Magnetization processes

عند ما تؤثر بمجال مغناطيسى على المادة الغير ممغنطة يزداد العزم المغناطيسى لها بأحد طريقتين او كليهما : -

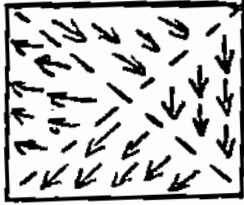


مغنطه بالدوران مغنطه بحركة حدود غير ممغنطة
المناطق المغناطيسية

شكل (١٣ - ٩)

أولاً : عن طريق تحرك حدود المناطق المغناطيسية حيث تنمو تلك المناطق migration of domain boundaries التي تكون اتجاهات حركتها المغزلية قريبة من اتجاه المجال المغناطيسي الخارجي على حساب تلك المناطق التي يكون اتجاهات حركتها اهزلية بعيدة عن اتجاه المجال .

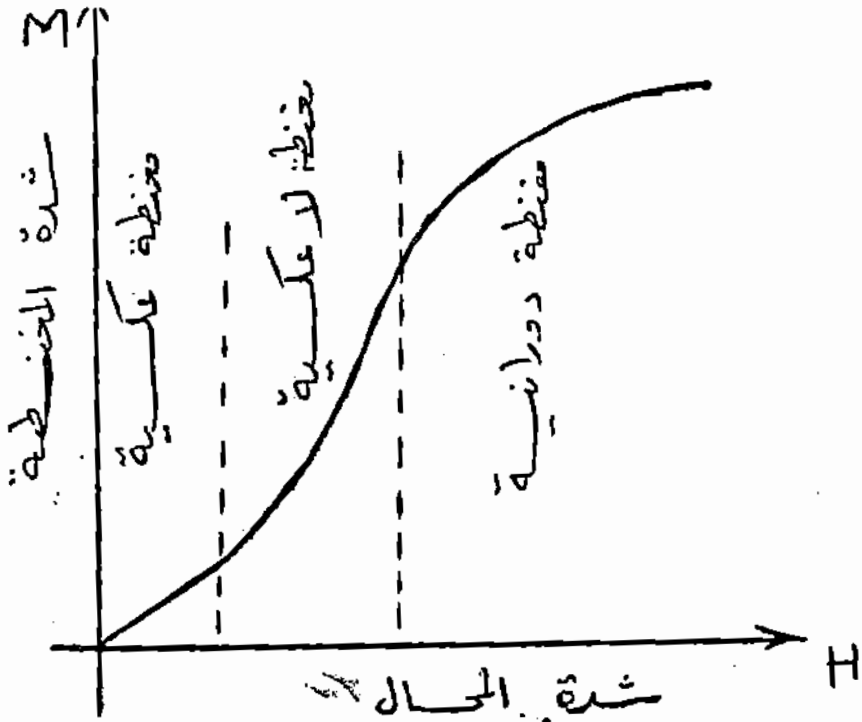
ثانياً : قد يتم التمتع عن طريق دوران اتجاه الحركات المغزلية وبالتالي دوران اتجاهات العزوم المغناطيسية داخل المنطقة الواحدة . وذلك لكي تتراص الحركات المغزلية في اتجاه المجال المغناطيسي .



وعادة ما تتم المغنطة في المجالات الضعيفة بواسطة تحرك حدود المناطق المغناطيسية ، ولكن عند ما يكون المجال قويا تتم المغنطة بطريقة دوران اتجاهات العزوم المغناطيسية الجزيئية .

شكل (١٢ - ١٠) لا دوران اتجاهات العزوم

يبين شكل (١٣ - ١١) منحى المغنطة حيث تظهر الطرق المختلفة للمجال .



شكل (١٣ - ١١)
(م ١٨ - مدخل الجوامد)

تأثير درجة الحرارة :

تتأثر المغنطة بدرجة بسيطة عند رفع درجة الحرارة ولكن عند الوصول الى درجة حرجة T_c تسمى درجة حرارة كوري نجد أن جميع مغنطة المادة تتلاشى وتتحول المادة الفيرو مغناطيسية الى مادة بارامغناطيسية فوق تلك الدرجة .

ولكى نفسر السبب في هذا الانتقال العجائى من حالة الفيرو الى حالة البارامغناطيسية عند الدرجة الحرجة دون حدوث انتقال تدريجى ، نعتبر المغنطة على أنها تحركات تعاونية بين مجاميع المغناطيسيات الجزئية ، وتحتاج الى طاقة عند تغيير اتجاه عزوم هذه المغناطيسيات الأولية .

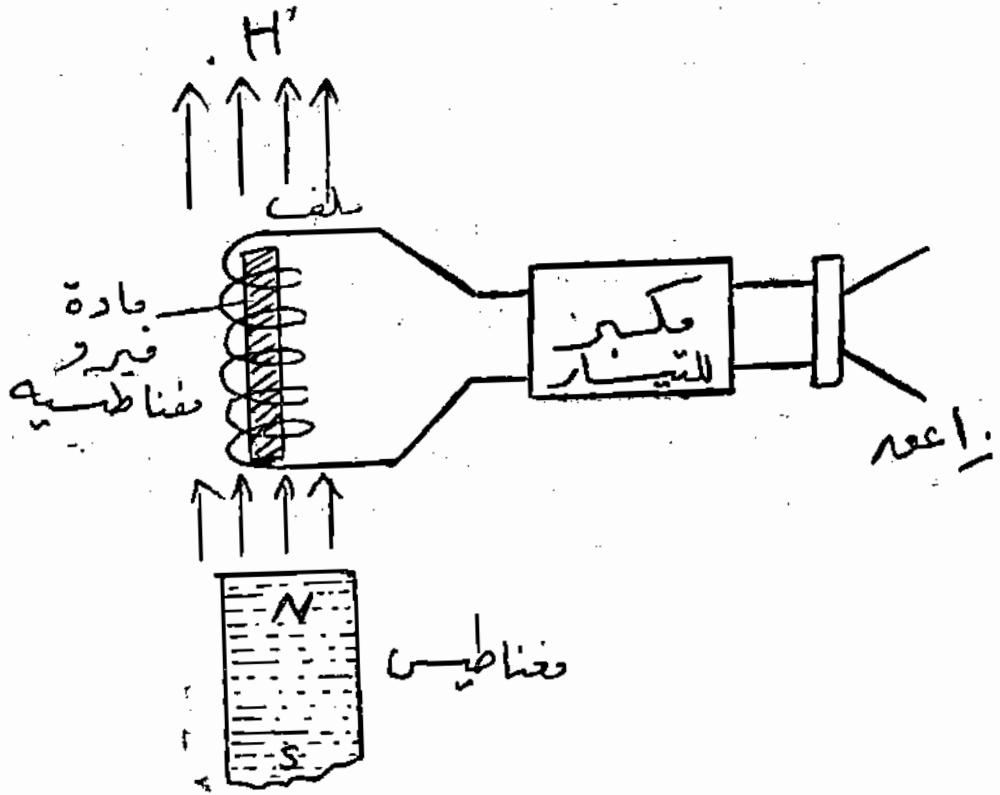
تمثلا في منطقة مغناطيسية معينة داخل مادة فيرومغناطيسية جميع المغناطيسيات الأولية فيها ذات ترتيب خاص واتجاه معين . ولذلك لا يمكن تغيير اتجاه اى مغناطيس اولى واحد فقط من المجموعة عن الاتجاه العام للباقيين اذ ان المجموعة كلها تمنع ذلك . ولذلك فان الطاقة اللازمة لهذا العمل تكون كبيرة جدا لا يستطيع فعلها التهييج الحرارى .

ولكن برفع درجة الحرارة حتى T_c يتلائم ترتيب اتجاهات هذه المغناطيسيات فجأة كما يحدث عادة في جميع الظواهر التعاونية Cooperative phenomenon.

ظاهرة باركهاوزن : The Barkhausen effect

في عام ١٩١٩ أثبت باركهاوزن بطريقة غير مباشرة وجود المناطق المغناطيسية domain structure

تتركب التجربة من ملف يوضع بداخله المادة الفيرومغناطيسية ويتصل الملف بمكبر للتيار ثم زاعق .



شكل (١٢ - ١٣)

تجربة باركها وزن

عند تقريب مغناطيس دائم من المادة الفيرومغناطيسية تتغير المغنطة في المادة . هذا التغير يتم بطريقة فجائية عندما يزداد حجم المناطق المغناطيسية التي تكون المغناطيسات الأولية فيها مرتبة في اتجاه المجال الخارجى في لحظة ازدياد المغنطة تقطع خطوط القوى المغناطيسية الملاف فينشأ عن ذلك تيار تأثيرى . وتكبير التيار بواسطة المكبر يسمح بأن نسمع أصوات مميزة لتلك الحركات اثناء التمهبط . وقد قدر التغير في حجم المناطق كل مرة يسمع فيها صوت بما يعادل 10^{-8} سم^٢

اما الاثبات المباشر لوجود مناطق مغناطيسية فقد تم بواسطة اشكال Bitter patterns وذلك عام ١٩٣١

وتتلخص الطريقة في تحضير سطح البلورة الفيرومغناطيسية بعناية بحيث يكون الملسا، ثم توضع عليه قطره من محلول غروى colloidal solution يحتوى معلقا دقيقا من مادة فيرومغناطيسية مثل الماجنتيت magnetite (سوداء اللون) .

عند النظر تحت الميكروسكوب الضوئى لسطح البلورة نجد ان هذه الذرات المعلقة بالمحلول (ذرات الماجنتيت) قد شكلت خطوطا سوداء يطلق عليها أشكال بيتر . وترسم هذه الخطوط حدود المناطق المغناطيسية على السطح .

والسبب في انجذاب جزيئات الماجنتيت لحدود المناطق هو ان بالقرب من هذه الحدود توجد مجالات مغناطيسية قوية محلية تجذب هذه الجزيئات .
strong local magnetic field